Облікова картка ДіР

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0315U005019

Державний реєстраційний номер: 0114U005600

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 02-02-2015

II. Етап виконання ДіР

Номер етапу: 1

Назва етапу: Розроблення технічної документації та виготовлення експериментальної партії сенсорів температури

Початок етапу: 06.2014

Закінчення етапу: 12.2014

Вид звітного документа: Без звіту

III. Відомості про виконавця ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Державне підприємство Науково-дослідний інститут "Оріон"

Код за ЄДРПОУ: 14310709

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 456-91-64, 456-52-91

IV. Відомості про співвиконавців ДіР

V. Відомості про замовника ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Інститут монокристалів НАН України

Код за ЄДРПОУ: 00210217

Місцезнаходження: просп. Науки, 60, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61072, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 380573410314

VI. Джерела, напрями та обсяги фінансування ДіР

Підстава для проведення ДіР: 52 - договір з вітчизняною організацією (органами місцевої ради, фондом, асоціацією, концерном тощо)

Напрям фінансування: 2.3 - виконання робіт за державними цільовими програмами

Джерела фінансування

7722 - кошти підприємств, установ, організацій України

Фактичний обсяг фінансування (тис. грн.): 25

VII. Відомості про ДіР

Назва роботи українською:

Розроблення технічної документації та виготовлення експериментальної партії сенсорів температури

Назва роботи англійською:

Development of technical documentation and production of experimental samples of temperature sensors

Реферат українською:

При виконанні НДР "Розроблення технічної документації та виготовлення експериментальної партії сенсорів температури" було розроблено ескізну конструкторську документацію на малогабаритний високостабільний сенсор температури на основі шарів високоомного карбіду кремнію завтовшки 1-3 мкм. Виготовлено експериментальну партію малогабаритного чіпа сенсора температури на основі наноструктурованих шарів високоомного карбіду кремнію на сапфірі. Проведено дослідження електричних параметрів виготовлених сенсорів.

Реферат англійською:

When performing research work "Development of technical documentation and production of experimental samples of temperature sensors" it was developed outline engineering documentation on a compact high-stability temperature sensor on a basis of high resistance layers of silicon carbide of 1-3 mkm thickness. Experimental batch of compact temperature sensor based on nano-structured layers of high resistance silicon carbide on sapphire. The study of electrical parameters of the sensors manufactured is performed.

Індекс УДК: 538.945, 621.382.232

Коди тематичних рубрик: 29.19.29

Керівники роботи

Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Кривуца В.А.

Науковий ступінь:

Вчене звання:

Ідентифікатор ORCID ID:

Додаткова інформація:

VIII. Наукова (науково-технічна) продукція (НТП)

Назва НТП українською: Ескізна контрукторська документація на малогабаритний високостабільний сенсор температури. Експериментальна партія малогабаритного чіпа сенсора температури .

Назва НТП англійською: Engineering documentation on a compact high-stability temperature sensor . Experimental batch of compact temperature sensor

НТП, яку передбачалося створити:

Причини, через які НТП не було створено:

Отримані результати:

Галузь застосування: 73.10.0 НВЧ напівпровідникове приладобудування для систем радіолокації, навігації та систем спецпризначення.

Реєстраційний номер картки технології:

Опис НТП: Ескізна контрукторська документація на малогабаритний високостабільний сенсор температури на основі шарів високоомного карбіду кремнію завтовшки 1-3 мкм. Експериментальна партія малогабаритного чіпа сенсора температури на основі наноструктурованих шарів високоомного карбіду кремнію на сапфірі.

Соціально-економічна спрямованість НТП:

Вплив НТП на довкілля:

Впровадження НТП: Впроваджено

Практична реалізація НТП

Початок етапу: 2014

Закінчення етапу:

Споживачі продукції: Радіоелектроніка

Перспективні ринки: Україна

Характер співробітництва з інвестором

Потрібний обсяг інвестицій, тис. грн.:

Права, що надаються інвестору після завершення роботи:

Наявність бізнес-плану:

Техніко-економічне обгрунтування:

Потенціальний обсяг продажу, тис. грн.:

Очікуваний термін окупності (років):

Додаткова інформація:

IX. Бібліографічний опис

X. Заключні відомості

Керівник юридичної особи Мальцев Сергій Борисович

Перелік осіб-виконавців

Відповідальний за підготовку облікових документів

Телефон

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності

